

# DIODE MODULE ダイオードモジュール

## DF30NA80S/160S

UL; E76102(M)

### DF30NA80S/160S (SIP-Diode Module)

- Three Phase Rectifier Bridge

#### Advantages

- SIP (Single In-line Package)
- Very Low Forward Voltage Drop
- High Surge Current Capability
- RoHS directive compliance
- 2500V Isolation ratings

#### Applications

- Welding and Plasma Cutting Machines
- Battery Chargers
- Power Supplies
- Motor Controls
- Air Conditioner
- Home Appliance

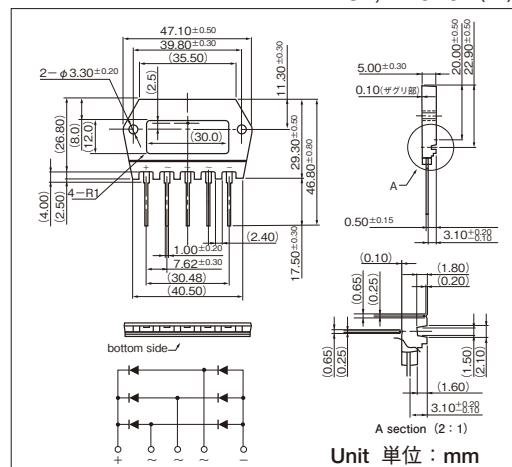
- 三相全波整流ダイオードモジュール

#### 特長

- シングル インライン パッケージ
- 低オン電圧
- 高サージ電流特性
- RoHS指令適合
- 絶縁耐圧2500V

#### 用途

- 溶接機・切断機
- 充電器
- 各種電源装置
- モーター制御
- エアコン
- 家電品



( $T_j=25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified / 特にことわらない限り  $T_j=25^\circ\text{C}$ )

Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値		Unit 単位
		DF30NA80S	DF30NA160S	
V <sub>RMM</sub>	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	800	1600	V
V <sub>RSM</sub>	Non-Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク非繰返し逆電圧	960	1700	V

Symbol 記号	Item 項目		Conditions 条件	Ratings 定格値	Unit 単位
I <sub>D</sub>	Output Current (D.C.) 直流出力電流		Three Phase full wave. $T_c=92^\circ\text{C}$ 三相全波整流回路	30	A
I <sub>FSM</sub>	Surge Forward Current サージ順電流		50Hz/60Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value 50Hz/60Hz 正弦半波 1サイクル 波高値 非繰返し	365/400	A
I <sup>2</sup> t	$I^2t$ 電流二乗時間積		Value for one cycle of surge current 1サイクルサージ順電流に対する値	660	A <sup>2</sup> s
T <sub>j</sub>	Operating Junction Temperature 接合部温度			-40~+150	°C
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature 保存温度			-40~+150	°C
V <sub>ISO</sub>	Isolation Breakdown Voltage (R.M.S.) 絶縁耐圧		Terminals to case, A.C. 1minute 主端子-ケース間, A.C. 1分間	2500	V
	Mounting Torque 締付トルク	Mounting (M3) 取付	Recommended Torque 0.5N·m 推奨値 0.5N·m	0.8	N·m (kgf·cm)
	Mass 質量		Typical Value 標準値	18	g

### Electrical Characteristics 電気的特性

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 規格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I <sub>RRM</sub>	Repetitive Peak Reverse Current 逆電流	$T_j=150^\circ\text{C}$ , $V_{RMM}=800\text{V}$			5	mA
		$T_j=150^\circ\text{C}$ , $V_{RMM}=1600\text{V}$			14	
V <sub>FM</sub>	Forward Voltage Drop 順電圧降下	$T_j=25^\circ\text{C}$ , $I_{FM}=30\text{A}$ , Inst. measurement 瞬時測定			1.2	V
		$T_j=25^\circ\text{C}$			0.96	
V <sub>(TO)</sub>	Threshold Voltage 閾値電圧	$T_j=150^\circ\text{C}$			0.85	V
		$T_j=25^\circ\text{C}$			8	
rt	Dynamic Resistance オン抵抗	$T_j=150^\circ\text{C}$			10.3	mΩ
		$T_j=25^\circ\text{C}$			0.8	
R <sub>th(j-c)</sub>	Thermal Impedance 熱抵抗	Junction to case per one module 接合-ケース間			0.8	°C/W
R <sub>th(c-f)</sub>	Interface Thermal Impedance 接触熱抵抗	Case to Heat sink ケース-ヒートシンク間 Thermal conductivity(Silicon grease) $\approx 7 \times 10^{-3} [\text{W}/\text{cm}\cdot\text{°C}]$ シリコングリースの熱伝導率 $\approx 7 \times 10^{-3} [\text{W}/\text{cm}\cdot\text{°C}]$			0.13	°C/W

